

## عملکرد یک نانوحس گر در ساختار تلفیقی بلور فوتونی - میکرو دیسک

رقیه حمیدی، احمد رضا دارائی، عاطفه محسنی فرد

زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، کد پستی ۹۸۱۳۵-۶۷۴

چکیده - یکی از ویژگی‌های بلورهای فوتونی، محبوس‌سازی مدهای نوری در حجم مدی کوچک و با فاکتور کیفیت بسیار زیاد است. از جمله ساختار هندسی این بلورها، میکرو دیسک بوده که مدهای محبوس در آن تحت نام ویسپرینگ گالری شناخته شده و در نزدیکی جداره داخلی دیواره دیسک تمرکز می‌یابند. در این مقاله، به ارائه ساختار تلفیقی یک میکرو دیسک با یک آرایه دایروی از حفره‌های هوا مکعبی که در نزدیکی پیرامون آن تعبیه شده و تشکیل یک بلور فوتونی حلقوی را برای کنترل بیشتر مدها می‌دهد، پرداخته می‌شود. این حفره‌های هوای مکعبی توسط شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شده‌اند برای کاربرد یک نانوحس گر، طراحی و مهندسی می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی با روش المان محدود نشان می‌دهد که حجم مدی به اندازه  $0.077(\lambda/n)^3$  در ناحیه یک شیار مرکزی، قابل حصول است. ویژگی حس‌گری برای هندسه‌های مختلف دیسک، آرایه بلور فوتونی و ابعاد شیارهای متصله مورد آنالیز قرار گرفته و حساسیت قابل قبولی برابر با (نانومتر بر واحد ضریب شکست)  $100 \text{ nm/RIU}$ ، قابل دسترسی است.

کلید واژه- بلور فوتونی، نانوحس گر، نانوساختار، میکرو دیسک.

## Operation of a Nano-Sensor in the Joined Photonic Crystal-Microdisk Structure

S. Roghaye Hamidi, Ahmadreza Daraei, Atefeh Mohsenifard

Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, P. O. Box: 98135-674, Zahedan

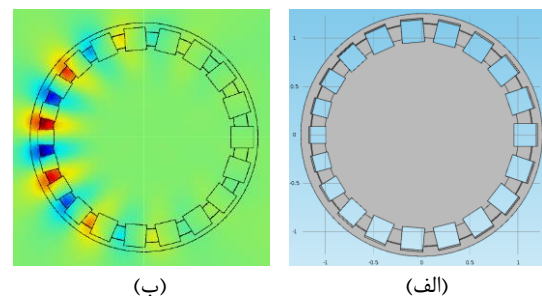
Abstract- One of the characteristics of the photonic crystals is the confinement of light in a small modal volume with high quality factor. The microdisk geometry is one of the photonic crystal structures that confine modes as the whispering gallery modes which are located near the marginal volume of the disk. In this paper, we present a combined microdisk system with a single circular array of cubical air-holes near its periphery to form an embedded circular photonic crystal and to provide a better control of the modes. These cubical air-holes are connected with grooves to a depth equal to a fraction of the thickness of the microdisk, designed and engineered for application of a nano-sensor. The finite element simulation results show that the modal volume can be as large as  $0.077(\lambda/n)^3$  in a region of a central groove. Sensor characteristics are analyzed for various disk geometries, photonic crystal arrays, and dimensions of the connecting slots. Acceptable sensitivities equal to  $100 \text{ nm/RIU}$  (refractive index unit) are accessible.

Keywords: Photonic Crystal, Nano-Sensor, Nano-Structure, Microdisk.

## ۱- مقدمه

بلورهای فوتونی به خاطر ویژگی‌های نوری و کاربردهایی که دارند بالاخص در دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند [۱-۳]. یکی از ویژگی‌های بلورهای فوتونی، محبوس‌سازی مدهای نوری در حجم مدی کوچک و داشتن فاکتور کیفیت بالای مدها است [۴-۶]. این ویژگی‌ها باعث کارایی بهتر ادواتی شده که برای کاربردهای خاص خود، به محبوس کردن نور در حجم کوچک نیاز دارند. از جمله این ادوات، حس‌گرهای نوری است که دارای گستره مصارف بسیاری از جمله حس‌گرهای شیمیایی و زیستی هستند [۷-۱۰]. ساختارهای مورد مصرف برای این منظور، دارای فیزیک و هندسه متنوعی هستند. در این‌جا حس‌گرهای بر مبنای کاواک نوری که بر پایه تغییر ضریب شکست کار می‌کنند، به خاطر داشتن حساسیت بالا، مورد توجه است [۷].

در این مقاله، به ارائه ساختار کاواک نوری پرداخته شده که تلفیقی از یک مشدد میکرو دیسک با یک آرایه از حفره‌های هوای مکعبی در یک مسیر دایروی است. این آرایه در نزدیکی پیرامون میکرو دیسک طراحی و اچینگ شده و بنابراین تشکیل یک بلور فوتونی تک‌آرایه حلقوی را می‌دهد. این حفره‌های هوای مکعبی به توسط شیاریایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شده‌اند، و برای کاربرد به‌عنوان یک نانوحس‌گر، طراحی و مهندسی می‌شوند. در شکل ۱، طرحواره‌ای از یک نمونه طراحی شده و مد ویسپرینگ گالری (whispering gallery mode) شبیه‌سازی شده در این مقاله، دیده می‌شود.



شکل ۱: الف) یک طرحواره از تلفیق مشدد دیسک-بلور فوتونی بعلاوه شیاری متصل‌کننده، برای کنترل و تمرکز بهتر مدهای ویسپرینگ گالری، نشان داده شده در (ب).

به این ترتیب همان‌طوری که در شکل ۱ (ب) دیده می‌شود، با این‌گونه تلفیق مشدد دیسک-بلور فوتونی

بعلاوه شیاریهای متصل‌کننده، کنترل و تمرکز مدها بهتر صورت می‌پذیرد، که در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتر به سازوکار آن و نتایج مستخرج از آن پرداخته می‌شود.

## ۲- ساختار نمونه مورد بررسی

ساختار پایه نمونه مورد شبیه‌سازی در این مقاله، در مرحله اول یک ساختار هندسی به فرم یک میکرو دیسک ساده، بوده است. مدهای محبوس در آن تحت نام ویسپرینگ گالری شناخته شده و در نزدیکی جداره داخلی دیواره دیسک تمرکز می‌یابند. میکرو دیسک با جداره‌های با هندسه‌های مختلف می‌توانند در کنترل تمرکز مدی نقش داشته باشند. بعلاوه، تمرکز مدهای مورد بحث می‌تواند در ناحیه‌ای از فضای دیسک به صورت موج‌های میراشونده جهت استفاده به‌عنوان حس‌گرهای زیستی، مورد بهره‌برداری قرار گیرند [۷]. برای این منظور، با حفر (اچینگ) یک شیاری در مسیر تشکیل این مدها، این ناحیه از امواج الکترومغناطیسی متمرکز انباشته می‌گردند. بهینه‌سازی به توسط تغییر مکان شعاعی شیاری و پهنا و عمق آن صورت می‌پذیرد.

حال در این مقاله، این ساختار پایه مشدد نوری، با به‌کارگیری یک آرایه از حفره‌های هوای مکعبی در یک مسیر دایروی، که به صورت تلفیقی از یک مشدد میکرو دیسک با تک‌آرایه بلور فوتونی حلقوی ظاهر می‌شود، بهبود داده شده است. این آرایه حفره‌های هوای مکعبی در نزدیکی پیرامون میکرو دیسک طوری طراحی و اچینگ شده که به توسط شیاریایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شده‌اند. به این ترتیب، با بهره‌مندی از این آرایش هندسی، تمرکز مدی بسیار بهتر با حجم مدی  $V_m$  بسیار کوچک حاصل می‌گردد. در این مبحث، حجم مدی  $V_m$  به توسط رابطه زیر تعریف می‌گردد [۶]:

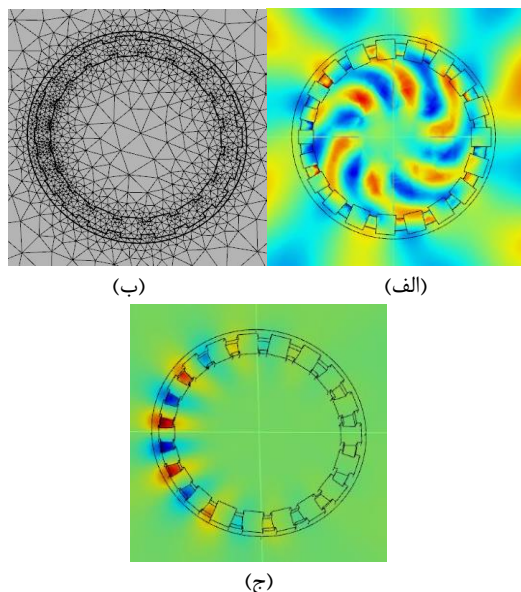
$$V_m \equiv \left( \int_V \epsilon(\vec{r}) |\vec{E}(\vec{r})|^2 d^3\vec{r} \right) / \max \left( \epsilon(\vec{r}) |\vec{E}(\vec{r})|^2 \right) \quad (1)$$

که در آن،  $\epsilon(\vec{r})$  ثابت دی‌الکتریک و  $\vec{E}(\vec{r})$  میدان الکتریکی مد است.

## ۳- شبیه‌سازی و آنالیز داده‌ها

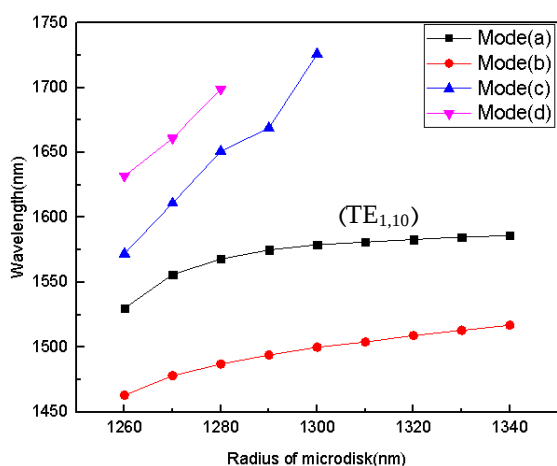
برای شبیه‌سازی در این مقاله، ابتدا به بهینه‌سازی مدهای

نانومتر بر تغییر واحد ضریب شکست ( $\text{nm}/\text{RIU}$ ) معرفی نمود.



شکل ۲: (الف) یک نمونه مش بندی برای بدست آوردن (ب) و (ج) الگوی توزیع مدی؛ در (ب) پراکندگی چشمگیر بوده در حالی که در (ج) تمرکز مدی در ناحیه شیار بین حفره های-هوای مکعبی در یک مسیر دایروی، مشهود است.

همان طوری که ذکر شد، قبل از این مراحل باید طول موج مدهای بهینه مطلوب تعیین شوند. برای این منظور، تغییرات طول موج مدهای مورد نظر با تغییرات شعاع میکرو دیسک در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳: تغییرات طول موج مدها از جمله مورد نظر ( $\text{TE}_{1,10}$ ) با تغییرات شعاع میکرو دیسک.

البته تحقیق شد که عموماً با افزایش شعاع دیسک و شماره سمتی مد، پرتوهای مدهای ویسپرینگ گالری به دیواره دیسک فشرده تر شده و در نتیجه، کاهش حجم

ویسپرینگ گالری محبوس شده در ساختار پایه نمونه میکرو دیسک ساده، پرداخته شده است. مدها به ناحیه حدود پنجره سوم مخابراتی ( $1550 \text{ nm}$ ) تنظیم طیفی شدند. در اینجا، از مد عرضی الکترومغناطیسی که با علامت  $\text{TE}_{p,m}$  مشخص شده ( $p$  عدد مرتبه شعاعی و  $m$  عدد مرتبه سمتی)، برای مد مرتبه اول شعاعی ( $p=1$ ) و مرتبه بالاتر سمتی ( $m=10$  و  $11$ )، استفاده گردیده است. تغییرات طول موج این مد برای شعاع های مختلف میکرو دیسک، مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شد.

در ادامه، یک آرایه از حفره های-هوای مکعبی در مسیر دایروی در نزدیکی پیرامون دیسک در مسیر تشکیل مدهای ویسپرینگ گالری، در نظر گرفته شد. بنابراین با این ترکیب، که متشکل از تلفیق یک بلور فوتونی حلقوی در نزدیکی جداره میکرو دیسک با خود مشدد میکرو دیسک میزبان است، مدهای تشدیدی جایگزیده تر شدند. سپس، این حفره های-هوای مکعبی به توسط شیاری با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شدند تا امواج میرایی که در ناحیه شیار مرکزی بیشتر تمرکز یافته اند، برای منظور نانوحس گری مورد بهره برداری قرار گیرند. شکل ۲ ب، یک نمونه مش بندی مورد استفاده در شبیه سازی با روش المان محدود ( $\text{Finite element method} - \text{FEM}$ ) را نشان می دهد. در شکل ۲ ب، یک نمونه الگوی توزیع مدی (پروفیل سطحی مد) به نمایش گذاشته شده است که معرف پراکندگی زیاد و عدم دستیابی به مد محبوس ناحیه ای است. در حالی که بعد از بهینه سازی ناحیه مطلوب با شدت موج الکترومغناطیسی ماکزیمم، مطابق شکل ۲ ج، بدست آمده است.

این ناحیه با شدت ماکزیمم، برای منظور حس گری مواد بیولوژیکی و شیمیایی می تواند، ویژگی شناسی ( $\text{characterize}$ ) گردد. بدین ترتیب باید ناحیه شیار بین حفره های-هوای مکعبی در مسیر دایروی جداره داخلی میکرو دیسک را بهینه سازی نمود. وقتی یک نمونه از این گونه مواد در این ناحیه قرار می گیرد، باعث تغییر در ضریب شکست این ناحیه از ساختار می گردد و در نتیجه طول موج مد تنظیمی مقداری جابه جا می گردد. این جابه جایی طول موج به ازای تغییر در ضریب شکست را می توان با رابطه  $S \equiv \Delta\lambda/\Delta n$  برای حس گری ( $S$ ) با واحد

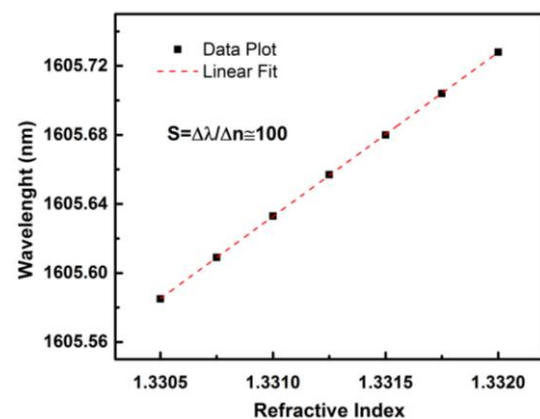
می‌یابند. این میکرو دیسک‌ها دارای ضخامتی کمتر از نصف طول موج هستند، تا امواج را در صفحه دیسک محدود کنند. در این مقاله، برای کنترل بیشتر مدها به طراحی و شبیه‌سازی ساختار تلفیقی از یک میکرو دیسک و یک آرایه دایروی از حفره‌های هوا مکعبی که در نزدیکی پیرامون آن تعبیه شده و تشکیل یک آرایه بلور فوتونی را می‌دهد، پرداخته شده است. برای مقاصد کاربردی مثلاً یک نانوحس گر، شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت میکرو دیسک، این حفره‌های هوا مکعبی را به هم مرتبط نمودند، تا مدهای مهندسی‌شده در اختیار قرار گیرند. نتایج شبیه‌سازی با روش المان محدود برای این ساختارها نشان می‌دهند که حجم مدی به اندازه  $0.077(\lambda/n)^3$  در ناحیه یک شیار مرکزی، قابل حصول است. خصوصیت حس‌گری برای هندسه‌های مختلف میکرو دیسک، که با آرایه بلور فوتونی تلفیق یافته و ابعاد شیارهای متصله متغیر در نظر گرفته شدند، مورد آنالیز قرار گرفته و حساسیت قابل قبولی برابر با (نانومتر بر واحد ضریب شکست) 100 nm/RIU، قابل ثبت است.

## مراجع

- [1] B. E. Saleh, M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*, Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & Sons, Inc., 2nd Ed. 2007.
- [2] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, R. D. Meade, *Photonic Crystals - Molding the Flow of Light*, Princeton University Press, 2nd Ed., 2008.
- [3] E. Yablonovitch, "Photonic band-gap crystals", *J. Phys. Condens. Matter* 5(16), 2443, 1993.
- [4] D. Sanvitto, A. Daraei, A. Tahraoui, M. Hopkinson, P. W. Fry, D. M. Whittaker, M. S. Skolnick, "Observation of ultrahigh quality factor in a semiconductor microcavity", *Appl. Phys. Lett.* 86, 191109, 2005.
- [5] M. I. Cheema, A. G. Kirk, "Accurate determination of the quality factor and tunneling distance of axisymmetric resonators for biosensing applications", *Opt. Express* 21(7), 8724-8735, 2013.
- [6] K. Srinivasan, M. Borselli, O. Painter, A. Stintz, S. Krishna, "Cavity Q, mode volume, and lasing threshold in small diameter AlGaAs microdisks with embedded quantum dots", *Opt. Express* 14(3), 1094-1105, 2006.
- [7] A. Daraei, M. E. Daraei, "Thin cylindrical slot in an optical microdisk cavity for sensing biomaterials", *Applied Physics A*, 123(4), p. 216, 2017.
- [8] J. M. Lourtioz, H. Benisty, V. Berger, J. M. Gérard, D. Maystre, A. Tchelepnokov, *Photonic Crystals: Towards Nanoscale Photonic Devices*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2nd Ed., 2008.
- [9] Cicek, K., Eryürek, M. and Kiraz, A., "Single-slot hybrid microring resonator hydrogen sensor", *JOSA B*, 34(7), pp.1465-1470, 2017.
- [10] S. M. Grist, S. A. Schmidt, J. Flueckiger, V. Donzella, W. Shi, S. T. Fard, J. T. Kirk, D. M. Ratner, K. C. Cheung, L. Chrostowski, "Silicon photonic micro-disk resonators for label-free biosensing", *Opt. Express* 21(7), 7994-8006, 2013.

مدی را به دنبال خواهد داشت. در مرحله طراحی ساختار با ۲۰ حفره-هوا مکعبی در حاشیه میکرو دیسک، افزایش ابعاد حفره، در حالی که شعاع میکرو دیسک ثابت است، کاهش حجم مدی را نتیجه می‌دهد. در ادامه بررسی، با وجود شیارهایی بین حفره‌های هوا تغییرات طول موج، حجم مدی و الگوی توزیع شدت مد محبوس شده بررسی گردیدند. مدهای مورد بررسی به گونه‌ای باید انتخاب گردند که کماکان بعد از تغییرات در یکی از پارامترها، همچنان در نواحی مورد نظر به‌طور مطلوب متمرکز باقی بمانند. با دستکاری پهنای شیار، افزایش تمرکز مد و یا به‌عبارتی کاهش بیشتر حجم مدی برای یک مد ویسپرینگ گالری، تا حدود  $0.077(\lambda/n)^3$  حاصل می‌گردد که در آن،  $\lambda$  طول موج مد مربوطه و  $n$  ضریب شکست مؤثر میکرو دیسک است.

برای مصارف کاربردی، از نظر عمل حس‌گری، با تغییرات ماده‌ای که قسمت مرکزی شیار را پر کرده، حساسیتی به میزان 100 nm/RIU به‌دست آمده است. شکل ۴، یک نمودار تغییرات طول موج مد بر حسب تغییرات ماده پرکننده شیار، نشان می‌دهد.



شکل ۴: نمودار تغییرات طول موج مد بر حسب تغییرات ماده پرکننده شیار.

## ۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

محبوس‌سازی مدهای نوری با فاکتور کیفیت بسیار زیاد و حجم مدی کوچک یکی از خصوصیات بلورهای فوتونی با هندسه‌های متفاوت، است. از جمله ساختارهای هندسی این بلورها، مشدد نوری میکرو دیسک بوده که مدهای محبوس در آن به نام ویسپرینگ گالری معروف بوده و در نزدیکی جداره داخلی دیواره جانبی دیسک تمرکز